تقريب الأحتواء القوي للشوائب المانحة في نقاط كم كروية GaAs تحت تأثير الضغط الهيدروستاتيكي

م.د لافي فرج عكلة
 م. مصطفى عبد الستار عبد الجبار
 قسم الفيزياء/كلية العلوم/جامعة ذى قار

الخلاصة:

يحسب هذا البحث تصحيحات الطاقة للرتبة الأولى للحالات الكمية s,p للشائبة الهيدروجينية الضحلة في مركز وداخل وخارج النقطة الكمية الكروية GaAs تحت تأثير الضغط الهيدروستاتيكي .تمت هذه الحسابات باستخدام تقريب الأحتواء القوي ضمن تقريب الكتلة الفعالة الذي يفترض بأن حجم النقطة يجب أن يكون أصغر من نصف قطر بور المؤثر . إن تأثير الضغط يؤدي إلى زيادة الأحتواء الكمي للشائبة داخل النقطة وبالتالي إلى زيادة تصحيحات الطاقة لأي نصف قطر نقطة وموقع شائبة . إن هذه التصحيحات تعتمد على موقع الشائبة وتأثير الضغط أقل ما يمكن عندما تكون الشائبة عند حافة النقطة.

Strong-confinement approach for donor impurities in GaAs spherical quantum dots under the pressure effect

Lafy F. AL-Badry and Mustapha A. Setar A. Jebar

Department of Physics, College of Science/ University of Thi-Qar.

Abstract

This paper calculates first-order energy correction for the states s and p of shallow hydrogenic impurity in center, interior and exterior GaAs spherical quantum dots under the effect of hydrostats pressure. These calculations studied by using the strong confinement approach within the effective mass approximation, which consider the size of the quantum dot, must be smaller than effective Bohr radius. Hydrostatic pressure rise quantum confinement of impurity interior Q.D, thus, energy correction increases for any radius of Q.D and position of impurity. These corrections depend on the position of impurity and pressure effect at the minimum value at the edge of Q.D.

Keywords: quantum dot, donor impurity and strong-confinement approach

المقدمة:

درس عدد من العلماء في السنوات العشرين الأخيرة حالات الشائبة في أنظمة أحتواء (confinement systems) متنوعة مثل أنظمة ذات البعدين (2D) وذات البعد (Quantum Wire) وذات البعد الواحد (1D) التي تسمى الأسلاك الكمية (Quantum Wire) وذات البعد الصفري (0D) والتي تسمى النقاط الكمية (Zhu et al. 1990), (Zhu et al. 1990), (و1989).

إن مسائل النقاط الكمية تعتبر مهمة لأن خواص التراكيب ذات الأبعاد الواطئة يمكن الحصول عليها بواسطة تغيير نصف قطر النقطة الكمية. عندما يكون نصف قطر النقطة الكمية كبير جداً، فإن الذرة الشائبة داخل النقطة الكمية سوف تسلك كذرة هيدروجين حرة ثلاثية البعاد (3D)، لأن الخواص الفيزيائية للإلكترونات سوف تختلف.

يمكن زيادة أحتواء الشائبة بزيادة نصف قطر النقطة الكمية ، وبذلك سوف تزداد الطاقة الحركية للإلكترون والتي بدورها سوف تتغلب على جهد التجاذب بين الإلكترون والذرة الشائبة عندئذ سوف تتغير الطاقة الكلية من سالبة إلى موجبة (Hsieh 2000) . إن تأثير الحجم الكمي في ثلاثة أبعاد للنقاط الكمية يؤدي إلى تصنيع مستويات طاقة متميزة تشبه المستويات الذرية في حزم التوصيل والتكافؤ والتي بدورها تؤدي إلى تغيرات هائلة في الخواص الفيزيائية التي لا تظهر في المواد الأعتيادية (bulk .

تبين الحسابات إن الأحتواء وطاقة الربط Binding Energy لذرة شائبة في نقطة كمية Q.D تعتمد على أرتفاع حاجز الجهد، وحجم ومادة النقطة الكمية (Haus *et al.* 1993) . كما تعتمد على شكل البلورة (Hens and Vanmaekelbergh) . كما (2002، لكن يكون تأثير الشكل ثانوي بينما تأثير موقع الشائبة يكون قوي على طاقة الربط وحالة الأحتواء . (2007) (2007) .

درس بعض العلماء في السنوات القليلة الماضية تأثير الضغط الهيدروستاتيكي (Hydrostatic Pressure) على تركيب الحزمة (bulk) في الأنظمة ثلاثية البعاد (bulk) و الأنظمة واطنة الأبعاد (low dimensions) بصورة نظرية وتجريبية . كما درس(Pěrezet al. 2007) تأثير الضغط الهيدروستاتيكي على طاقة الربط للحالة 18 للشوائب المائحة في وتجريبية . كما درس(Moscoso et al. 2007) تأثير الضغط الهيدروستاتيكي على طاقة الربط للحالة 18 للشوائب المائحة في نقاط كم GaAs بستخدام تقريب التغاير الضغط الهيدروستاتيكي على طاقة الربط للحالة 18 للشوائب المائحة في وتجريبية . كما درس(Moscoso et al. 2007) تأثير الضغط الهيدروستاتيكي على طاقة الربط للحالة 18 للشوائب المائحة في نقاط كم على طاقة الربط للحالة (Moscoso et al. 2007) تأثير الضغط الهيدروستاتيكي على طاقة الربط للحالة 18 للشوائب المائحة في نقاط كم كروية (SQD) يأثير الضغط تقويب التغاير المنعليونات الضوئية Elmeshad et al. 2007) تأثير الضغط درس (Interse وتوريب التغاير .كما قام الباحثون(Rob et al. 2007) بينما درس (SQD) للحالة 18 باستخدام تقريب التغاير .كما قام الباحثون(Rob et al. 2007) بينما درس (SQD) للحالة 18 باستخدام تقريب التغاير .كما قام الباحثون والفلاليتونات الضوئية Elmeshad et al. 2007) بلائي المنعلم درس (Interse et al. 2012) بلائلة الضغط درس (Interse et al. 2012) للحالية والمعنا والما الهيدروستاتيكي على ماقة الربط للأكسايتونات تحت تأثير الضغط الهيدروستاتيكون (Interse et al. 2003) بلحساب طاقة ربط الأكسايتونات تحت تأثير الضغط درس (Interse et al. 2012) بلحواص الطيفية للنقاط الكمية الأسطوانية تحت تأثير المحالات الكهربائية والمغناطيسية المنظمة سويةً مع مجال مائوسية.

النموذج الحسابى:

نفرض نقطة كمية كروية (SQD) من مادة GaAs تحتوي على شوائب ضحلة تحت تأثير الضغط الهيدروستاتيكي، وباستخدام تقريب الكتلة الفعالة Effective Mass Approximation وإن الهاملتون الذي يصف هذه الحالة هو Ferreyra) and Proetto 1995)

$$H = \frac{-\hbar^2}{2m^*(p)\lambda^2} \nabla^2 - \frac{e^2}{\varepsilon(p)\lambda} V(\vec{r}, \vec{r_i}) \quad \dots \dots \quad (1)$$

حيث أن \overline{r} هو أحداثي الإلكترون ، \overline{r}_i أحداثي الشائبة ، ∇^2 مؤثر لابلاس في الإحداثيات الكروية ،إن المعامل χ هو ثابت مقداره $\overline{r}_i \sim \lambda = R/a_{\circ}^*$ مقداره $\lambda = R/a_{\circ}^*$ مقداره $\lambda = R/a_{\circ}^*$ نصف قطر النقطة dielectric constant معداره $m^*(p), \varepsilon(p)$ هو ثابت العزل dielectric constant والكتلة المؤثرة للإلكترون effective mass كدالة للمعد إن المعامل عدا مع مقداره العند والذي يأخذ الصيغة والكتلة المؤثر والمائرة بين الإلكترون والمائرة التقطيم والكتلة المؤثر والمؤثرة للإلكترون effective mass الكمية المؤثرة للإلكترون والمائرة للإلكترون والمائية المؤثرة التوليغة الموثرة للإلكترون والمائية والذي يأخذ الصيغة المونية المؤثرة الإلكترون والمائية المؤثرة الإلكترون والمائية الموثرة التوليغة الموني والمائية الموثرة الإلكترون والمائية الموني والكترة التولي والمائية الموني والمائية والمائية الموني والمائية الموني والمائية الموني والمائية التولي والمائية التولي والمائية الموني والمائية والمائية الموني والمائية والمائية والمائية الموني والمائية والمولية والمائية الموني والمائية والمولي والمائية والمولي والمائية والمولي والمائين والمائي والمائية والمولي والمائين والمائية والمائية والمائية والمائية والمائية والمولي والمائية والمولي والمولي والمائية والمولي والمولي

$$V(\vec{r}, \vec{r}_i) = \sum_{\ell=0}^{\infty} p_{\ell}(\cos\xi) \left\{ \eta(1-r_i) \left[\frac{r_{\zeta}^{\ell}}{r_{\zeta}^{\ell+1}} \right] + \eta(r_i-1) \frac{r^{\ell}}{r_i^{\ell+1}} \right\} \dots \dots (2)$$

حيث $\mathcal{E}_2, \mathcal{E}_1$ هي ثوابت العزل الكهربائي لمادة اللب والقشرة الخارجية على الترتيب. في المعادلة ($\mathcal{E}_2, \mathcal{E}_1$ هو متعدد حدود ليجندر للرتبة ℓ ، ℓ هي الزاوية بين الإلكترون والمانحة (التي تقاس من نقطة الأصل عند مركز النقطة الكمية)، r_i هو البعد الأصغر بين r_i, r, r_i يا بعد الأصغر بين r_i, r, r_i دالة الخطوة step function .

من الهاملتون (1) يمكن ملاحظة أن الطاقة الحركية تعتمد على $1/\lambda^2$ بينما تفاعل كولوم يعتمد على $1/\lambda$ لذلك عندما يكون λ مى الهاملتون (1) يمكن ملاحظة أن الطاقة الحركية تعتمد على فاز التصحيح ، وإن هذا التقريب يسمى تقريب الأحتواء للقوي (Strong Confinement Approach (Ferreyra *et al.* 1997 .

إن الصيغة العامة لدالة الموجة هي :

$$\psi_{n\ell m}(r,\theta,\phi) = N_{n\ell} j_{\ell}(kr) Y_{\ell m}(\theta,\phi) \dots (3)$$

لغرض تحقيق الشرط $0 = \frac{\hbar^2}{2m^*R^2} x_{n\ell}^2$ يتم الحصول على طيف القيمة الذاتية للطاقة $\sum_{n\ell} x_{n\ell}^2 x_{n\ell}^2 = 3$ ، حيث $N_{n\ell}$ هو الغرض تحقيق الشرط 0 = (k(r = R)) = 0، حيث $N_{n\ell}$ هو الغرض تحقيق الشرط الذي يأخذ القيمة $Y_{\ell m}(\theta, \phi) = \frac{1}{p_{\ell}(kr)}$ ، $N_{n\ell}^2 = \frac{2}{R^3} \frac{1}{\left[j_{\ell+1}(x_{n\ell})\right]^2}$ هي التوافقيات المعايرة الذي يأخذ القيمة $Y_{\ell m}(\theta, \phi)$ ، ويقد مثل دوال بزل الكروية، $j_{\ell}(kr) = \frac{2}{R^3} \frac{1}{\left[j_{\ell+1}(x_{n\ell})\right]^2}$ هي التوافقيات الكروية، $X_{n\ell}$ هي جذور دالة بزل الكروية الرتبة y_{ℓ} .

من خلال العلاقة التالية $E^{(1)} = \langle n \ell m | V | n \ell m \rangle$ يمكن الحصول على التصحيح للرتبة الأولى، وبذلك يمكن حساب طاقة الربط

$$E_b(R,r_i,p) = \frac{1}{\lambda^2} \frac{\hbar^2}{2m^*(p)R^2(p)} x_{n\ell}^2 - \frac{1}{\lambda} E^{(1)}(R,r_i,p) \dots (4)$$

 $r_i \leq R$ يمكن أن نحسب التصحيح من المرتبة الأولى للحالات ns يمكن أن نحسب التصحيح من المرتبة الأولى الحالات

$$E_{n00}^{(1)}(R,r_i,p) = \frac{e^2}{\varepsilon(p)R(p)} \left[1 - \frac{\sin(2\bar{r}_i)}{2\bar{r}_i} + Cin(2x_{n0}) - Cin(2\bar{r}_i) \right] \dots \dots (5)$$

$$\overline{r}_i = \frac{r_i x_{n0}}{R}$$
حيث

أما في حالة $r_i
angle R$ فإن التصحيح سوف يكون

$$E_{n00}^{(1)}(r_i, p) = \frac{e^2}{\varepsilon(p)r_i} \dots \dots \dots (6)$$

وعندما تكون المانحة عند مركز النقطة الكمية $r_i=0$ فإن التصحيح يأخذ الصيغة التالية:

$$E_{n00}^{(1)}(R,r_i=0,p) = \frac{e^2}{\varepsilon(p)R(p)}Cin(2x_{n0})\dots(7)$$

حيث (Cin(x هي دالة تكامل (Arfken 2001)(cosine integral function).

إن أنصاف الأقطارو ثوابت العزل الكهربائي والكتل المؤثرة لمادة GaAs تعطى بدلالة الضغط (Pěrezet al. 2007):

$$R(p) = R_{\circ} (1 - 1.5082 \times 10^{-4} p) \dots (8)$$

$$\varepsilon(p) = 13.13 - 0.0088 p \dots (9)$$

$$m^*(p) = m^*(0) \exp(0.0078 p) \dots (10)$$

حيث p هو الضغط الذي يقاس بوحدات R_o،kbar هو نصف قطر النقطة الكمية عند p=0. يمكن أن نجري نفس الخطوات لحساب التصحيح من الرتبة الأولى للحالات المثارة 1 $\pm n = 1, m = 1, m = 1$ مع أفتراض أن المانحة تتحرك على طول المحور Z أي أن $heta_i, \phi_i = 0$

عند الشرط
$$R \leq r_i \leq 0$$
 فأن التصحيح للحالة (n10) هو

$$E_{n10}^{(1)}(R,r_i,p) = \frac{e^2}{\varepsilon(p)} \Big[A(R,r_i,p) + B(R,r_i,p) \Big] \dots \dots \dots (11)$$

حيث أن

$$A(R, r_i, p) = \frac{N_{n1}}{2a^2} (\alpha + \beta) \ B(R, r_i, p) = \frac{4}{5} \frac{S^2}{R(p) j_2^2(x_{n1})} (\gamma + \delta)$$

$$a = \frac{x_{n1}}{R(p)}$$
, $S = \frac{r_i}{R(p)}$, $\alpha = 1 - \frac{2\sin^2(\bar{r}_i)}{\bar{r}_i^2} + \frac{\sin(2\bar{r}_i)}{2\bar{r}_i}$

$$\beta = \frac{\sin^2(\bar{r}_i)}{\bar{r}_i^2} - \frac{\sin^2(x_{n1})}{x_{n1}^2} + \frac{\sin(2x_{n1})}{x_{n1}} - \frac{\sin(2\bar{r}_i)}{\bar{r}_i} + Cin(2x_{n1}) - Cin(2\bar{r}_i)$$
$$\gamma = \frac{1}{2x_{n1}^5} S^5 \left[\left(\frac{\bar{r}_i^2}{2} - \frac{5}{4} \right) \sin(2\bar{r}_i) + \frac{3}{2} \bar{r}_i \cos(2\bar{r}_i) + \bar{r}_i + \frac{\bar{r}_i^3}{3} \right]$$
$$\delta = \frac{1}{4} \left[\frac{\sin^2(\bar{r}_i)}{\bar{r}_i^4} - \frac{\sin^2(x_{n1})}{x_{n1}^4} + \frac{1}{\bar{r}_i^2} - \frac{\sin(2\bar{r}_i)}{\bar{r}_i^3} + \frac{\sin(2x_{n1})}{x_{n1}^3} - \frac{1}{x_{n1}^2} \right]$$

أما عند الشرط $r_i \geq R$ فإن التصحيح

$$E_{n10}^{(1)}(R,r_i,p) = \frac{e^2}{\varepsilon(p)} \left[\frac{1}{r_i} + \frac{2}{5} \frac{N_{n1}W}{r_i^3} \right] \dots \dots \dots (12)$$

حيث أن

$$W = \left(\frac{R(p)}{x_{n1}}\right)^{5/2} \left[x_{n1} + \frac{x_{n1}^3}{3} + \left(\frac{x_{n1}^2}{2} - \frac{5}{4}\right)\sin(2x_{n1}) + \frac{3}{2}x_{n1}\cos(2x_{n1})\right]$$

عندما يكون العدد الكمي المغناطيسي $m = \pm 1$ أي الحالة $(n1 \pm 1)$ فإن الأختلاف سيكون فقط في الحد الثاني من المعادلة (11)

$$B(R, r_i, p) = \frac{-2}{5} \frac{S^2}{Rj_2^2(x_{n1})} (\gamma + \delta)$$

$$\left(\frac{-1}{5} \frac{N_{n1}W}{r_i^3}\right) u_i = 0$$
(12) Market in the second s

ولكن عندما تكون المانحة عند مركز النقطة الكمية $(r_i=0)$ فإن التصحيح يأخذ الصيغة التالية:

$$E_{n1(0,\pm1)}^{(1)}(R,r_i,p) = \frac{N_{n1}}{2a^2}\beta(r_i=0)$$
 (13)

النتائج والمناقشة:

الأشكال (1,2,3)تمثل تصحيحات الطاقة للرتبة الأولى للحالات 1s,2s,3s للشوائب الضحلة Shallow Impurities في نقاط كم كروية في بئر ذات عمق لانهائي كدالة لموقع الشائبة بنصف قطر النقطة R=50A° عندما يسلط عليها ضغوط هيدر وستاتيكية Hydrostatic Pressure مختلفة p=0,20,40 kbar، والتي تم حسابها من العلاقات (7,5)



الشكل(2): تصحيحات الطاقة من الرتبة الأولى للحالة 2s كدالة لموقع الشائبة $h=r_{_{i}}/R$ لنقاط كم كروية بنصف قطر R=50A° بضغط مختلف R=50A

70

50

40

30 20

0

E⁽¹⁾(meV) 60





الشكل(3): تصحيحات الطاقة من الرتبة الأولى للحالة 35 كدالة لموقع الشائبة لنقاط کے کرویے بنصف قطر R=50A° لنقاط کے کرویے بنصف ال $h=r_i/R$ مختلفp=0,20,40kbar

يتبين من هذه الأشكال أن تصحيحات الطاقة تقل كلما تحركت الشائبة من مركز النقطة 0 = r_i/R إلى حافتها r_i/R = 1 ، ويكون هذا السلوك على وتيرة واحدة بسبب التناظر الكروي للكثافة الإلكترونية للحالات ns . إن النتائج في الشكل (1) مطابقة للنتائج في المصدر (Pěrezet al. 2007). كلما أزداد الضغط المسلط أزدادت تصحيحات الطاقة، مما يسبب إحتواء إلكتروني أكبر في النظام ، وإن هذه الزيادة تعتمد على موقع الشائبة حيث يكون تأثر ها أقل ما يمكن عند حافة النقطة الكمية .

أما الأشكال (7,6,5,4) فإنها تبين تصحيحات الطاقة للرتبة الأولى للحالات 1p^{0,±1},2p^{0,±1} كذالة لموقع الشائبة بنصف قطر R=50A⁰ تحت ضغوط هيدروستاتيكية مختلفة p=0,20,40، وإن هذه النتائج تم حسابها من العلاقات -11) (13والتي تكون مطابقة للنتائج في المصدر (Ferreyra and Proetto 1995). يتضح من الأشكال (7,6) إعتماد تصحيحات الطاقة على موقع الشائبة والذي يكون على وتيرة واحدة ، كلما أبتعدت الشائبة عن مركز النقطة سوف تقل تصحيحات الطاقة وهذا ناشئ من تراكم الشحنة السالبة للحالات (1±1) في المستوي x-y عندما تتحرك الشائبة على طول محور z

لكن في الحالات (n10) كما في الأشكال (5,4) فإن أعتماد تصحيح الطاقة على موقع الشائبة لا يكون على وتيرة واحدة، بسبب تراكم الشحنة السالبة على طول محور z الذي تتحرك عليه الشائبة، إن أعلى قيم تصلها تصحيحات الطاقة عند موقع الشائبة c_i / R ≈ 0.5 ، والذي ينجلي واضحاً في الشكل (9) حيث تصحيحات الطاقة كدالة لأنصاف أقطار النقاط الكمية الكروية تحت ضغط ثابت p=20 kbar



الشكل(4): تصحيحات الطاقة من الرتبة الأولى للحالة 1p⁰ كدالة لموقع الشائبة لنقاط كم كروية بنصف قطر R=50A^o يضغط مختلفp=0.20.40kbar



الشكل(5): تصحيحات الطاقة من الرتبة الأولى للحالة 2p⁰ مالشكل(5): R=50A كدالةلموقع الشائبة لنقاط كم كروية بنصف قطر ٥٩٥ه المنغط مختلف p=0.20.40kbar



المصادر:

- Elmeshad N., Abdelhamid H., Hassanein H., Abdelmola S. and Said S., Exciton Binding Energy Dependence of Hydrostatic Pressure and Temperature inside a Cylindrical Quantum Dot. Chinese Journal of Physics 47, 92, 2009.
- 2- Ferreyra J.M., Bosshard P. and Proetto C.R., Strong-confinement approach for impurities in parabolic quantum dots. Phys. Rev. B 55, 13682, 1997.
- 3- Ferreyra J.M. and Proetto C.R., Strong-confinement approach for impurities in quantum dots. Phys. Rev. B 52, 2309, 1995.
- 4- G.Arfken, Mathematical Methods for Physicists. 5rded. Academic Press, Inc., 2001.

- 5- Haus J.W., Zhou H.S., Honma I. and Komiyama H., Quantum confinement in semiconductor heterostructure nanometer-size particles. Phys. Rev. B47, 1359, 1993.
- 6- Hens Z., Vanmaekelbergh D., Stoffels E. and Van K. H., Effects of crystal shape on the energy levels of zero-dimensional PbS quantum dots. Phys. Rev. Lett. 88, 236803, 2002.
- 7- Hsieh C.Y.,Lower lying states of hydrogenic impurity in a multi-layer quantum dot. Chinese Journal of Physics 38, 478, 2000.
- 8- Ikhdair S. M., Hamzavi M. and Sever R., Spectra of cylindrical quantum dots: The effect of electrical and magnetic fields together with AB flux field. Physica B 407, 4523–4529, 2012.
- 9- Karimi M.J., Rezaei G. and Nazari M., Linear and nonlinear optical properties of multilayered spherical quantum dots: Effects of geometrical size, hydrogenic impurity, hydrostatic pressure and temperature. Journal of Luminescence 145, 55–60, 2014.
- 10- Moscoso C.A., Franco R. and Silva J., The binding energy of light excitons in spherical quantum dots under hydrostatic pressure. Revista Mexicana 53, 189, 2007.
- 11- Pěrez S.T., Bolivar L.E. and Revista J.S., The binding energy of donor impurities in GaAs quantum dots under the pressure effect. Mexicana De Fisica, 53470, 2007.
- 12- Zhu J.L., Xiong J.J. and Gu B.L., Confined electron and hydrogenic donor states in a spherical quantum dot of GaAs-Ga_{1-x} Al_xAs. Phys.Rev.B 41, 6001, 1990.
- 13- Zhu J.L., Exact solutions for hydrogenic donor states in a spherically rectangular quantum well. Phys. Rev. B 39, 8780, 1989.